科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):半導体基板上に重元素吸着することにより表面一次元原子鎖試料を作成し,時間・ス ビン・角度分解光電子分光(ARPES)を用いて,スピン軌道相互作用によりスピン分裂した表面一次元金属電子 の特異な電子状態を解明することを目的として研究を行った。白金-ゲルマニウム,金-ゲルマニムからなる表面 一次元合金の研究では,そのフェルミ面とバンド構造を実験的に決定した。Bi(111)表面状態の研究では,レー ザー光を用いた軌道選択スピン分解光電子分光を行い,表面電子のスピン軌道結合状態を明らかにした。さら に,レーザー光のパルス特性を利用した時間分解ARPESを行い,伝導帯へ励起された電子の緩和過程を解明し た。

研究成果の概要(英文): The electronic band structures of one-dimensional atomic chains grown on semiconductor substrates were investigated by time-, spin- and angle-resolved photoelectron spectroscopy (ARPES). In the studies of platinum- and gold-induced atomic nanowires formed on germanium (001) substrates, we have experimentally determined the electronic band structures and their Fermi surfaces. In the study of bismuth (111) surface, the spin-orbital entanglement of a surface state was observed by orbital-selective spin-resolved ARPES using a polarization-variable vacuum ultraviolet laser. In addition, a general description of the spin-orbital entanglement of the spin-polarized surface state was revealed. From the time-resolved ARPES using a pump-and-probe method, the large pump-and-probe response of the Bi(111) surface states was found and the decay process of the electrons excited into the conduction bands was clarified.

研究分野:固体電子物性

キーワード:表面金属電子 スピン軌道相互作用 スピン分解光電子分光 時間分解光電子分光

1. 研究開始当初の背景

空間反転対称性の破れによってスピン偏極した電子に関する研究が盛んに行われている。固体表面・界面における二次元電子系では、トポロジカル絶縁体表面やラシュバ型スピン分裂を示す表面などが知られており、強いスピン・軌道相互作用を示す重元素を含んだ表面を中心に研究が行われている。

一方、一次元電子系のスピン縮退が解けた ときに、そのスピン構造がどうなっているか は重要な問題である。一次元電子系では、対 称性の低下や異方的な電荷密度分布により, 三次元・二次元系とは異なるスピン構造が現 れることが予想される。このようなスピン偏 極した一次元電子は、重元素吸着させた半導 体基板上の一次元原子鎖試料において形成 可能であるが,その研究例は三次元・二次元 系と比較すると極端に少ない。また、一次元 金属電子のフェルミ面は、パイエルス不安定 性や朝永-ラッティンジャー液体状態の出現 により不安定化するが,スピン縮退が解けた 系におけるフェルミ面の不安定性を解明す ることも重要である。このような一次元系の 特異なスピン状態を解明するためには、通常 の角度分解光電子分光(ARPES)だけでは なく、三次元的にスピン分解と角度分解がで きる光電子分光 (3D-SARPES) を用いて, 電子バンドの三次元的なスピン構造を高精 度で決定することが必須である。

さらに、スピン偏極した表面電子のダイナ ミクスも興味深い。伝導帯へ光励起された電 子は、フェムト秒〜ピコ秒の時間スケールで フォノンと相互作用して、その後、価電子帯 中の正孔と再結合して緩和されるが、その緩 和過程はバンドのスピン構造や価電子帯の 正孔濃度に大きく依存するはずである。通常 の ARPES や SARPES は、系の時間平均さ れた状態を観測しているが、時間分解 (Tr-)ARPES・SARPES によりスピン偏極電 子のダイナミクスを解明できる。

2. 研究の目的

本研究では、半導体基板上に重元素を吸着 することにより表面一次元原子鎖試料を作 成し、SARPES を用いて一次元金属電子の スピンに依存したバンド構造を明らかする。 さらに、基底状態としてスピン縮退が解けて いる一次元金属電子のフェルミ面の不安定 性についても解明する。また、Tr-(S)ARPES 装置を新たに開発して、伝導帯へ光励起され たスピン偏極した表面金属電子が価電子帯 に緩和する<u>ダイナミクス</u>も明らかにする。

3. 研究の方法

本研究では、ARPES、3D-SARPES、Tr-ARPES を用いて固体表面の電子状態について調べた。

(1) ARPES

固体に紫外光~X線を照射すると光電効果 により固体中から電子が放出され、この電子 を光電子と呼ぶ。ARPES では光電子のエネル ギーと放出角度を分析し、そこから固体中に おいてその電子がどのように振る舞ってい たかを知ることができる。

(2) 3D-SARPES

SARPES では電子のエネルギーと運動量に 加えてスピン構造も知ることができる。実験 装置は ARPES+スピン検出器という形になっ ており,まず通常の ARPES により光電子のエ ネルギーと放出角度を分析し,その後にスピ ン検出器を用いてスピンの向きを識別する。 我々の実験装置では三次元的にスピン構造 を調べることができるスピン検出器を採用 している。

(3) Tr-(S) ARPES

Tr-(S) ARPES では光電子分析器は(S) ARPES と同じであるが,励起光に短パルスのレーザ ーを用いる。最初のパルスで固体中の電子を 伝導帯へ励起し,励起電子が価電子帯へ緩和 する前に次のパルスで真空中へ励起するこ とで伝導帯のバンド構造や電子緩和のダイ ナミクスを観測できる。

4. 研究成果

構造を詳細に調べた。

(1) PtGe 表面一次元合金の電子状態[1] 白金(Pt)原子を Ge(001)表面上に蒸着する と,Pt 原子に誘起された一次元原子鎖 (Pt/Ge(001) NWs)が自己組織的に形成される。 このような表面一次元構造は、ラッティンジ ャー液体やパイエルス転移など、一次元電子 特有の物性を研究するための舞台となる。ま た,重元素である Pt を含んでいるので、そ の Pt 由来の電子状態はラシュバ効果により スピン偏極することも予想される。本研究で は、ARPES を用いて、Pt/Ge(001) NWs の電子



図 1. Pt/Ge(001) NWs のフェルミ面[1]。

図1にARPESで観測されたPt/Ge(001)NWs のフェルミ面を示す。 S_1 - S_4 で示す4つの金属 的表面状態が観測された。 S_1 は直線的なフェ ルミ面を持つ理想的な一次元金属バンドで ある。 S_2 は基板との相互作用により二次元波 数空間内で波打った形状のフェルミ面を持っている。S₃は二つに分裂しており,SARPES から Pt の強いスピン軌道相互作用によりス ピン偏極した状態であることがわかった。



図2. S₁ バンドのフェルミ準位近傍の光電子 スペクトル[1]。

図2には一次元金属バンドである S_1 のフ ェルミ準位近傍の高分解能光電子スペクト ルを示す。ここで光電子強度は状態密度に比 例していると見なすことができる。 S_1 バンド の E_F 上での状態密度は理想的なフェルミ液 体である Au と比較すると減少している。こ れは S_1 電子がラッティンジャー液体状態あ る可能性を示唆している。

(2) Au/Ge 表面一次元合金の電子状態[2]

Au 原子を Ge (001) 表面上に蒸着すると,自 己組織的に表面一次元原子鎖 (Au/Ge (001) NWs) が形成される。ドイツのグループの先行 研究によりこの表面の電子状態は一次元的 であり,ラッティンジャー液体であると報告 された。一方,日本のグループの先行研究で は,この系の表面電子バンドは二次元的な性 質を有しているとの指摘もあり議論が交わ されていた。また,この表面は重元素である Au を含んでいることから,その表面状態は Au の強いスピン軌道相互作用によりスピン 偏極している可能性がある。このような背景 に基づいて,本研究では,高分解能 ARPES を 用いて Au/Ge (001) NWs の詳細な電子状態の 研究を行った。



図 3. (a) Au/Ge(001) NWs のJ点周りでのバンド マッピング。(b) Au/Ge(001) NWs 表面バンドの 概略図 (c) S₁の ARPES 強度の二階微分図[2]。

図3(a)にJ点近傍でのバンドマッピング の結果、図3(b)には実験結果をもとに描い たバンド構造の概略図を示す。 S_1, S_2, S_2' と いう3つの電子ポケットが観測されている。 結合エネルギー5 meV で得られた等エネルギ 一面はフェルミ面と見なすことができ, S₁, S₂ 'のフェルミ面は二次元波数空間 k_x-k_v内 S_{2} で閉じている。これは、Au/Ge(001)表面の電 子状態が明確に二次元的であることを示し ており、ドイツのグループによる先行研究に おけるこの表面が雨樋型の一次元電子バン ドを有するという主張を完全に否定する。ま た,これらの二次元バンドの状態密度はフェ ルミ準位近傍で大きく減少していることが わかった。ドイツのグループの先行研究では これをラッティンジャー液体の証拠として いた。しかしながら、この表面状態は二次元 的であるのでラッティンジャー液体という 主張はできない。我々は表面構造のディスオ ーダーによってバンド電子が局在化してい るため,フェルミ準位近傍で状態密度が減少 したと結論付けた。

図3(c)は Γ J方向で測定された ARPES 図で ある。図中に二つの矢印で示すように表面バ ンドが二つに分裂していることを見出した。 この分裂は Au のスピン軌道相互作用による ものと考えられる。今後 SARPES を行うこと により解明できる。

(3) 強くスピン軌道結合した表面状態と励 起電子の光スピン制御[3,4]

近年、トポロジカル物質に代表されるよう に強いスピン軌道相互作用によりスピン偏 極した表面状態の研究が盛んに行われてい る。このような物質系においてスピン偏極表 面状態のスピンベクトルの方向は電子の運 動量にロックされているというのがスタン ダードなモデルである。一方最近、トポロジ カル絶縁体 Bi,Se,において、表面電子状態の スピンは軌道成分と結合していることが指 摘された,スピン軌道エンタングルメントと 呼ばれている。この概念は、トポロジカル表 面状態に限らず, 強いスピン軌道相互作用を 示す表面電子系に対して,一般的な概念にな るはずである。本研究では, Bi 単結晶表面の スピン偏極表面電子状態について、偏光依存 SARPES を行った。

図4(a,b)にp偏光励起及びs偏光励起の SARPESで得られたBi(111)表面の FM 鏡映面 内でのスピン分解バンド図を示す。p偏光と s偏光では観測されるスピンの向きが反転し ていることがわかる。光学遷移のパリティ選 択則を考慮すると,鏡映面に対して対称(非 対称)な軌道は上向き(下向き)スピンと結 合しているといえる。量子力学の計算から, この結果は強いスピン軌道相互作用により スピン偏極した表面電子状態全般に適用で きることも示した。

一方,入射直線偏光の電場ベクトルを鏡映 面に対して回転させる(p 偏光や s 偏光から



図4. (a,b) p 偏光・s 偏光励起 SARPES によるスピン分解バンド図。青・白・赤でス ピン偏極度の大きさをあらわす。白がス ピン偏極度ゼロで,青と赤が±1である。 (c,d) p 偏光・s 偏光を用いた光励起の概略 図。p 偏光では対称軌道, s 偏光では非対 称軌道を選択的に励起する。(e) 直線偏光 の電場ベクトルを回転させた時の光電子 のスピン偏極度とその絶対値[3]。(f) 直線 偏光の電場ベクトルを入射面に対して回 転させた時の光励起の概略図。スピン干 渉による励起電子のスピンが回転する。 [3,4]

ずらす)と、鏡映面上の電子状態から放出された光電子であっても、スピンは鏡映面垂直 方向以外にも偏極成分を持つことを見出した。また、偏光電場ベクトルの向きに依存して光電子スピンの向きが変化することも発見した。これらは、同時励起された $|\psi_{\text{even},\uparrow}\rangle$ と $|\psi_{\text{odd},\downarrow}\rangle$ が量子力学的に干渉し、スピンの向きが回転したことによると説明される [3,4]。直線偏光電場ベクトルの回転角度に



図 5. (a) HOPG 基板上に作成した Bi(111)単結晶薄膜の Tr-ARPES 図。(b,c) フェルミ準位近傍の角度積分した光電子 強度。各色で時間発展を表している。(b) では光電子強度を線形プロット, (c)では 光電子強度を対数プロットで示している [5]。

対する光電子スピンの応答を定式化し,光ス ピン制御の基本概念を確立した。

(4) Bi 表面状態の Tr-ARPES

図5は, Tr-ARPES で観測した Bi (111) / HOPG のバンド構造である。光源は Yb ファイバー レーザーで,実験ではポンプ光として1.2 eV, プローブ光として 5.9 eV の光を使用してい る。レーザーパルスの繰り返し周波数は 95 MHz である。この装置のエネルギー分解能は 11 meV, 時間分解能は 310 fs と見積もられ ている。図5(a)より,ポンプ光を照射する 前はフェルミ準位より上の伝導帯側には光 電子強度は無いが、照射後にはフェルミ準位 より上に電子が励起されるため、伝導帯のバ ンドが観測されている。図5(b,c)には角度 積分した光電子強度の時間発展を示してい る。ポンプ光照射直後よりにフェルミ準位直 上の光電子強度が増大しはじめ、0.74 ps 後 に最大になり、その後およそ 20 ps の時間で 励起された電子が緩和していることがわか った。本研究より、伝導帯に光励起されたス ピン偏極表面状態がどのような時間スケー ルで緩和していくかが解明された。

<引用文献>

 K. Yaji *et al.*,他 8 名, 1 番目, J. of Phys.: Cond. Matter **28**, 284001, (2016).
 K. Yaji *et al.*,他 9 名, 1 番目, J. of Phys.: Cond. Matter **30**, 075001, 2018.
 K. Yaji *et al.*, Nat. Commun. **8**, 14588, (2017)
 <u>东治</u>他,固体物理 **52**, 559 (2017).

(5) Y. Ishida *et al.*, Rev. of Sci. Instrum. 87, 123902, (2016).

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計13件)

 Experimental Methods for Spin- and Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy Combined with Polarization-Variable Laser, Kenta Kuroda, <u>K. Yaji</u>,他5名,2番目, JoVE, 2018 (in press) 査読有,

https://www.jove.com/video/57090/expe

 ${\tt rimental-methods-for-spin-angle-resol}$

ved-photoemission

f

- レーザー励起スピン分解光電子分光で解き明かす光スピン制御,<u>矢治光一郎</u>,黒田健太、小森文夫,辛埴,日本光学会 47,142-147,2018,査読有, http://myosj.or.jp/publication/kogaku/latest/
- ③ レーザ光で電子のスピン方向を自在に制御,<u>矢治光一郎</u>,黒田健太,小森文夫,辛埴,レーザ加工学会,25,39-42,2018,査読有, http://www.jlps.gr.jp/journal/25-1.pd
- ④ Surface electronic states of Auinduced nanowires on Ge(001), <u>K. Yaji</u>, R. Yukawa, 他9名, 1番目, Journal of Physics: Condensed Matter, 30, 075001, 2018, 査読有,

doi.org/10.1088/1361-648X/aaa526

- ⑤ 固体表面電子におけるスピン軌道エンタングルメントと光スピン制御, <u>矢治光一</u>
 <u>郎</u>,黒田健太,小森文夫,辛埴,固体物理 52,559-571,2017,査読有, http://www.agne.co.jp/kotaibutsuri/in dex.htm
- ⑥ Modulation of electron-phonon coupling in periodically-nanorippled graphene on a macrofacet of 6H-SiC, K. Ienaga, T. Iimori, <u>K. Yaji</u>,他11名,3番目,Nano Letters 17,3527,2017,査読有 DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00606.
- ⑦ Spin-dependent quantum interference in photoemission process from spin-orbit coupled states, <u>K. Yaji</u>, K. Kuroda,

他 8 名,1 番目, Nature Communications 8, 14588, 2017, 査読有

DOI: 10.1038/ncomms14588

⑧ Topologically entangled Rashba-split bands on the grey arsenic surface, P. Zhang, J.-Z. Ma, 他 14 名, 7 番目, Physical Review Letters, 118, 046802, 2017, 査読有

DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.046802

 ⑨ Direct mapping of spin and orbital entangled wave functions under interband spin-orbit coupling of giant Rashba spin-split surface states, R. Noguchi, K. Kuroda, <u>K. Yaji</u>, 他6名, 3番目, Physical Review B 95, 041111(R) 2017, 査読有

DOI: 10.1103/PhysRevB.95.041111

W High repetition pump-and-probe photoemission spectroscopy based on a compact fiber laser system, Y. Ishida, T. Otsu, 他 5 名, 4 番目, Review of Scientific Instruments 87, 123902, 2016, 査読有

DOI: 10.1063/1.4969053

 ① Coherent control over threedimensional spin polarization for the spin-orbit coupled surface state of Bi₂Se₃, K. Kuroda, <u>K. Yaji</u>, 他8名, 2 番目, Physical Review B 94, 165162, 2016, 査読有

DOI: 10.1103/PhysRevB. 94.165162

- ① One-dimensional metallic surface states of Pt-induced atomic nanowires on Ge(001), <u>K. Yaji</u>, S. Kim, 他8名, 1 番目, Journal of Physics: Condensed Matter, 28, 284001, 2016, 査読有 DOI:10.1088/0953-8984/28/28/284001
- Bigh-resolution three-dimensional spin- and angle-resolved photoelectron spectrometer using vacuum ultraviolet laser light, <u>K. Yaji</u>, A. Harasawa, 他 9 名, 1 番目, Review of Scientific Instruments 87, 053111, 2016, 査読有 doi: 10.1063/1.4948738

〔学会発表〕(計16件)

- (1) 矢治光一郎, Laser-SARPES による新たな スピン物性研究, SPRUC 顕微ナノ・表面放 射光・SPM 合同シンポジウム, 2018
- ② 矢治光一郎, グラフェン/SiC 界面における Sn 単原子層のスピン分解光電子分光, 日本物理学会, 2018
- ③ 矢治光一郎, Laser-SARPES で解明するス ピン軌道エンタングルメントと光スピン 制御, フォトンファクトリー研究会, 2017
- ④ 矢治光一郎,貴金属(111)表面電子状態の スピン軌道エンタングルメントと laser-SARPES,日本物理学会,2017
- (5) Koichiro Yaji, Development of highresolution three-dimensional spin- and

angle-resolved photoelectron spectroscopy apparatus using vacuum ultraviolet laser, 33rd European conference on surface science, 2017

- ⑥ 矢治光一郎、レーザースピン分解光電子 分光で解明するスピン偏極表面電子状態、 第 37 回表面科学学術講演会、2017
- ⑦ Koichiro Yaji, Spin polarization of spin-orbit coupled states studied by laser-SARPES, 16th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces, 2017
- ⑧ 矢治光一郎、レーザースピン分解光電子 分光による Pb/Ge(111)のスピン偏極表 面電子状態と光電子スピンの研究、日本物 理学会、2017
- ⑨ 矢治光一郎、レーザースピン分解光電子 分光を用いた新たなスピン物性研究,第4
 回 JASRI ワークショップ,2017
- ① 矢治光一郎、レーザースピン分解光電子 分光で解明するスピン軌道分裂表面電子 状態からの光電子スピン、第36回表面科 学学術講演大会、2016
- ① 矢治光一郎, 偏光可変レーザースピン分 解光電子分光で解明する光電子スピン偏 極度と波動関数の位相, 日本物理学会, 2016
- ② 矢治光一郎, 偏光可変レーザースピン分 解光電子分光による Bi(111)表面電子状 態の研究, 日本物理学会, 2016
- ③ 矢治光一郎、レーザー光励起による高効率・高分解能三次元スピン分解光電子分光装置の開発 II、日本物理学会、2015

[その他]

http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/mainconte nts/organization/sor.html

6. 研究組織

(1)研究代表者
 矢治 光一郎(YAJI, Koichiro)
 東京大学・物性研究所・助教
 研究者番号: 50447447